

請求の範囲

- [請求項1] 基材上に粘着剤層を備え、前記粘着剤層上にフィルム状接着剤を備えてなり、
前記粘着剤層の厚さが $20\mu\text{m}$ ～ $50\mu\text{m}$ であり、
前記粘着剤層の破断伸度が $5\sim 50\%$ である、ダイシングダイボンディングシート。
- [請求項2] 前記粘着剤層が非エネルギー線硬化性である、請求項1に記載のダイシングダイボンディングシート。
- [請求項3] 前記粘着剤層の前記フィルム状接着剤に対する粘着力が $35\sim 300\text{mN}/25\text{mm}$ である、請求項1又は2に記載のダイシングダイボンディングシート。
- [請求項4] 請求項1～3のいずれか一項に記載のダイシングダイボンディングシートを用いた、半導体チップの製造方法であって、
前記ダイシングダイボンディングシートにおける前記フィルム状接着剤の、前記粘着剤層が設けられている側とは反対側の表面に、半導体ウエハが設けられてなる中間構造体を形成する工程と、
ダイシングブレードを用いて、前記中間構造体において、前記半導体ウエハの表面から前記粘着剤層に到達するとともに、前記基材には到達しない切れ込みを形成することで、前記半導体ウエハを分割して半導体チップを形成する工程と、を有する、半導体チップの製造方法。
- [請求項5] 請求項4に記載の半導体チップの製造方法により、前記半導体チップを形成する工程を行った後、
前記切れ込みを形成後のダイシングダイボンディングシートに対して、その基材側から力を加えるとともに、前記半導体チップを、切断後の前記フィルム状接着剤とともに前記粘着剤層から引き離す工程を有する、半導体装置の製造方法。